

器件参数表

DataSheet

ICW6215【开关电源控制器集成电路】



合肥艾创微电子科技有限公司

高性能、低成本离线式PWM控制功率开关

概述

ICW6215是一款高性能低成本PWM控制功率器，适用于离线式小功率降压型应用场合，外围电路简单、器件个数少。同时产品启动模块内置高压MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。

与传统的PWM功率开关不同，ICW6215内部无固定时钟驱动MOSFET，系统开关频率随负载变化可实现自动调节。同时芯片采用了多模式PWM控制技术，有效简化了外围电路设计，提升线性调整率和负载调整率并消除系统中的可闻噪音。此外，芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节，可以有效降低空载情况下的待机功耗。

ICW6215集成有完备的带自恢复功能的保护功能：VDD欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和VDD过压保护等。

特点

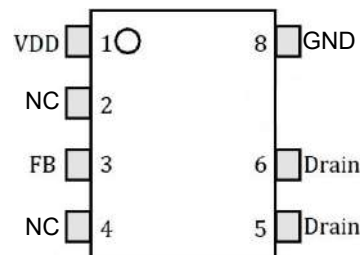
- VIN: 11~180V(OUT:ADJ)
- 集成 2.5A 180V MOS
- 集成 200V 高压启动电路
- 多模式控制、无异音工作
- 支持降压和升降压拓扑
- 默认13.5V 输出（FB 脚悬空）
- 待机功耗低于 50mW
- 良好的线性调整率和负载调整率
- 集成软启动电路
- 内部保护功能：
 - 过载保护 (OLP)
 - 逐周期电流限制 (OCP)
 - 输出过压保护 (OVP)
 - VDD 过压、欠压和电压箝位保护

典型应用

- 电信90V电源系统
- 以太网PoE
- 工业控制
- 逆变器系统

封装形式

- SOP-7



俯视图

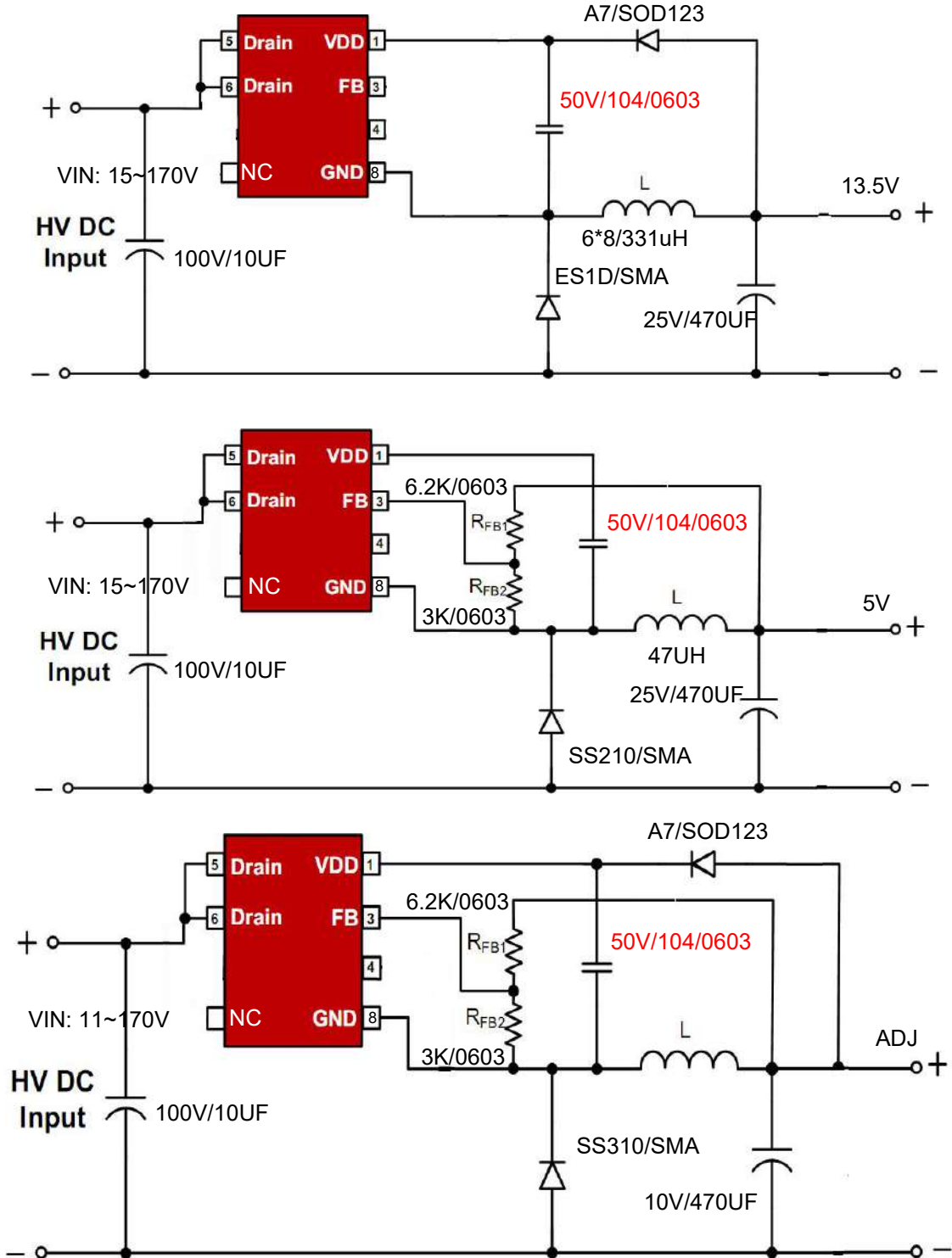
应用推荐

产品型号	封装	内阻	输出电压	输出电流
ICW6215	SOP-7	1.15Ω	>2V	600mAI_o<650mA
ICW6215D	SOP-7	1.15 Ω	>2V	600mAI_o<650mA

注：1、默认降压型输出。2、实际输出功率取决于输出电压和散热条件。

高性能、低成本离线式PWM控制功率开关

典型应用电路



推荐外围参数 如需改动请和原厂联系

高性能、低成本离线式PWM控制功率开关

管脚功能描述

管脚	名称	I/O	描述
1	VDD	P	芯片供电管脚，同时作为输出电压反馈端（FB 悬空时）。典型应用中 VDD 电容推荐采用 0.1uF 陶瓷电容
2	NC		
3	FB	I	反馈输入管脚，该引脚悬空时默认 13.5V 输出
4	NC		
5,6	Drain	P	内部高压 MOSFET 漏极
8	GND		芯片的参考地

订购信息

型号	描述
ICW6215	SOP-7, 无卤、编带盘装, 4000 颗/卷
ICW6215D	SOP-7, 无卤、编带盘装, 4000 颗/卷

高性能、低成本离线式PWM控制功率开关

极限参数(备注1)

参数	数值	单位
Drain 管脚电压	-0.3 to 190	V
VDD 供电电压	30	V
VDD 箝位电流	10	mA
FB, CS 管脚电压	-0.3 to 7	V
封装热阻---结到环境(SOP-8)	165	°C/W
最高芯片工作结温	160	°C
储藏温度	-65 to 150	°C
管脚温度 (焊接 10 秒)	260	°C
ESD 能力 (人体模型)	3	KV
ESD 能力 (机器模型)	250	V

推荐工作条件(备注2)

参数	数值	单位
工作环境温度	-40 to 140	°C
开关频率	AP TO LP	kHz

电气参数(无特殊注明, 环境温度为25°C)

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
高压启动部分 (HV 管脚)						
I_{HV}	HV 脚供电电流	HV=150V, VDD=0V	1	2		mA
$I_{HV_leakage}$	HV 脚漏电电流	HV=150V, VDD=13.5V			10	uA
供电部分(VDD 管脚)						
V_{DD_Reg1}	VDD 调制电压	FB悬空		13.5		V
I_{VDD_st}	VDD 启动电流	无开关工作		100	300	uA
I_{VDD_Op}	VDD 工作电流			800		uA
I_{VDD_Q}	VDD 静态电流			200		uA

高性能、低成本离线式PWM控制功率开关

VDD_OVP	VDD 过压保护阈值		28		V
VDD_Clamp	VDD 钳位电压	IVDD=10mA	30		V
反馈部分 (FB 管脚)					
VFB_REF	内部差分放大器输入端基准		1.97	2.0	2.03 V
VFB_OVP	输出过压保护 (OVP) 检测阈值		2.4		V
VFB_OLP	输出过载保护 (OLP) 检测阈值		1.87		V
TD_OLP	过载保护延迟时间		50		ms
电流检测输入部分 (CS 管脚)					
TLEB	前沿消隐		350		ns
TD_OCP	过流比较器延时		100		ns
VIPK	峰值电流阈值		0.5		V
VAOCP	异常过流保护检测阈值		0.9		V
计时部分					
T _{OFF_min_norm}	典型最短关断时间		14.5	16	17.5 us
T _{OFF_max_norm}	典型最长关断时间		1.4		ms
T _{OFF_max_FDR}	动态响应模式下最长关断时间		420		us
T _{ON_max}	最长导通时间		12		us
T _{ss}	内部软启动时间		3		ms
T _{Auto_Recovery}	自动恢复延迟时间		500		ms
过热保护					
TSD	过热保护阈值	(备注 3)	150		°C
功率 MOSFET 部分 (Drain 管脚)					
VBR	功率 MOSFET 击穿电压		190		V
R _{dson}	静态导通阻抗	ICW6215	1.15		Ω
		ICW6215D	1.15		Ω

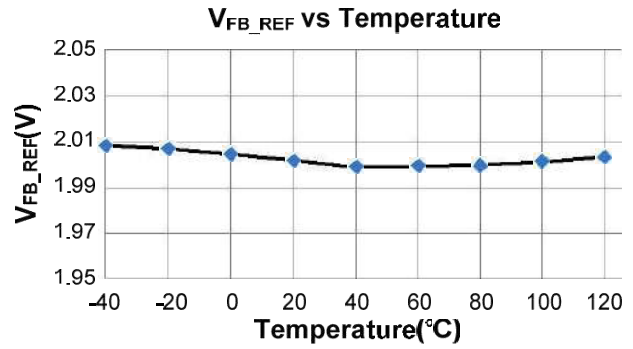
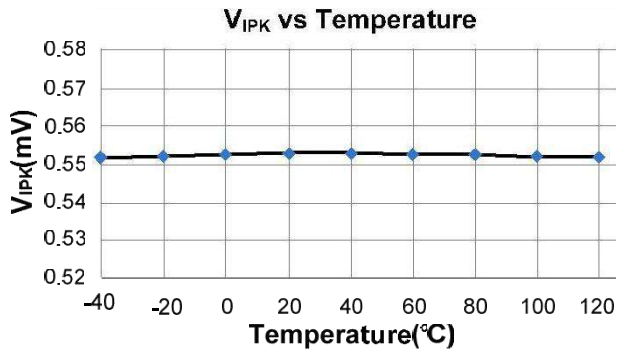
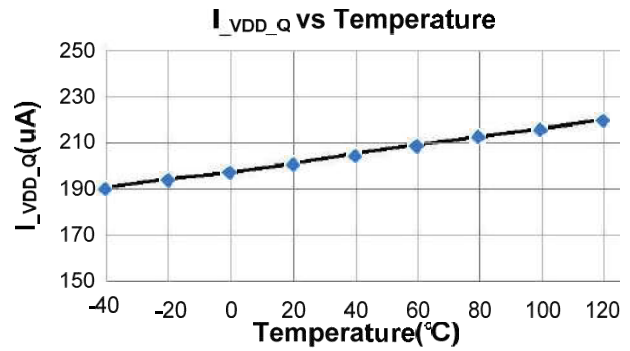
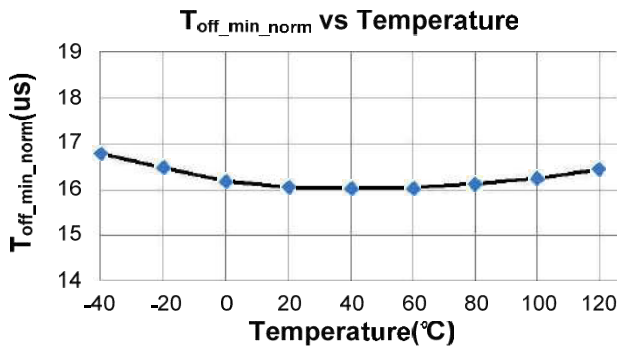
备注 1: 超出列表中“极限参数”可能会对器件造成永久性损坏。极限参数为应力额定值。在超出推荐的工作条件和应力的情况下, 器件可能无法正常工作, 所以不推荐让器件工作在这些条件下。过度暴露在高于推荐的最大工作条件下, 可能会影响器件的可靠性。

备注 2: 在超出以上参数的条件下, 无法保障芯片的正常运行。

备注 3: 参数取决于实际设计, 在批量生产时进行功能性测试

高性能、低成本离线式PWM控制功率开关

参数特性曲线



高性能、低成本离线式PWM控制功率开关

功能描述

ICW6215系列是一款集成高压启动和供电功能的多模式PWM控制功率开关。该系列产品支持离线式非隔离降压和升降压型拓扑电路，适用于小家电电源和线性电源替代等场所。同时，ICW6215具有输出精度高和外围成本低的特点。

- 超低静态工作电流

ICW6215 的静态工作电流典型值为200uA。如此低的工作电流降低了对于 VDD 电容大小的要求，同时也可以提高系统效率。

- 高压启动电路和超低待机功耗 (<50mW)

ICW6215内置有一个200V高压启动单元。在开机过程中该启动单元开始工作，从 HV 端取电并通过高压电流源对VDD电容进行充电，如“功能模块”中所述。当VDD 电压上升至 V_{DD_ON} 时，芯片开始工作且芯片工作电流增加至约0.8mA。在稳态工作时，芯片通过反馈二极管由输出进行供电，同时借助高压启动电路，系统待机功耗可以低至50mW以下。

- 逐周期峰值电流限制和前沿消隐

ICW6215内置的峰值电流检测阈值具有随系统工作频率变化而变化的特点，并通过CS管脚实现对电感峰值电流的调制。当CS管脚采样到的电压超过该阈值时，功率MOSFET立即关断直至下一开关周期开始。同时芯片内置有前沿消隐电路（消隐时间约300ns），消隐期间内部的逐周期峰值电流比较器将被屏蔽而不能关闭MOSFET。

- 多模式 PWM 控制

为满足系统平均效率和空载待机方面的严格要求，ICW6215 采用了调幅控制（AM）和调频控制（FM）相结合的工作模式。

满载情况下系统工作于调频模式（FM）；重载至轻载阶段，系统同时工作于调频和调幅模式（FM+AM）中，以达到良好的调整率和较高的系统效率；当工作于空载附近时，系统将重新进入调频模式以降低待机损耗。通过这种方式，可以将系统待机功耗降至50mW以下。

- 软启动

ICW6215内集成有 4ms（典型值）的软启动电路，在芯片启动过程中系统开关频率逐渐增加，而且每次系统的重新启动都会伴随着一次软启动过程。

- 输出过压保护（OVP）

当在连续的3个工作周期里ICW6215检测到FB脚电压高于2.4V以上时，芯片将进入输出电压过压保护（OVP），随后系统将进入自动重启模式。

- 过载保护(OLP)/短路保护(SLP)

当过流或短路情况发生时，输出电压和反馈电压将降低且低于输出过载保护阈值 V_{FB_OLP} 。如果在48ms（典型值）的时间内该状态持续存在，则芯片将停止开关动作并进入自动重启模式（如下描述）。

高性能、低成本离线式PWM控制功率开关

- 异常过流保护 (AOCP)

在某些情况下(如重载或者输出短路等), 系统的电感电流峰值将上升过于剧烈。为避免电感峰值电流过大对系统元器件造成损坏, 芯片内部设计有异常过流检测模块 (AOCP, 典型阈值为 0.9V)。当CS 电压高于该阈值时, 内部功率 MOSFET 即刻关断并保持关断状态持续。

- 过热保护(OTP)

ICW6215 内部集成的过热保护电路会检测芯片的内部结温, 当芯片结温超过 150°C (典型值) 时, 系统进入到自动重启模式。

- 优化的动态响应

ICW6215 集成有快速动态影响功能, 可降低负载切换时的输出电压跌落。

- 消除可闻噪音

ICW6215 通过采用频率调制和CS 峰值电压调制相结合的多模式控制方式, 可实现在全负载范围内有效消除可闻噪音。

- VDD 过压保护(OVP)和 VDD 电压箝位

当 VDD 电压高于 V_{DD_OVP} (典型值 28V) 时, 芯片将停止工作。随后 VDD 电压下降至 V_{DD_OFF} (典型值) 并进入重启模式。此外, 芯片内部集成有 30V 稳压管, 避免 VDD 脚电压过高而损坏。

- 自动重启保护

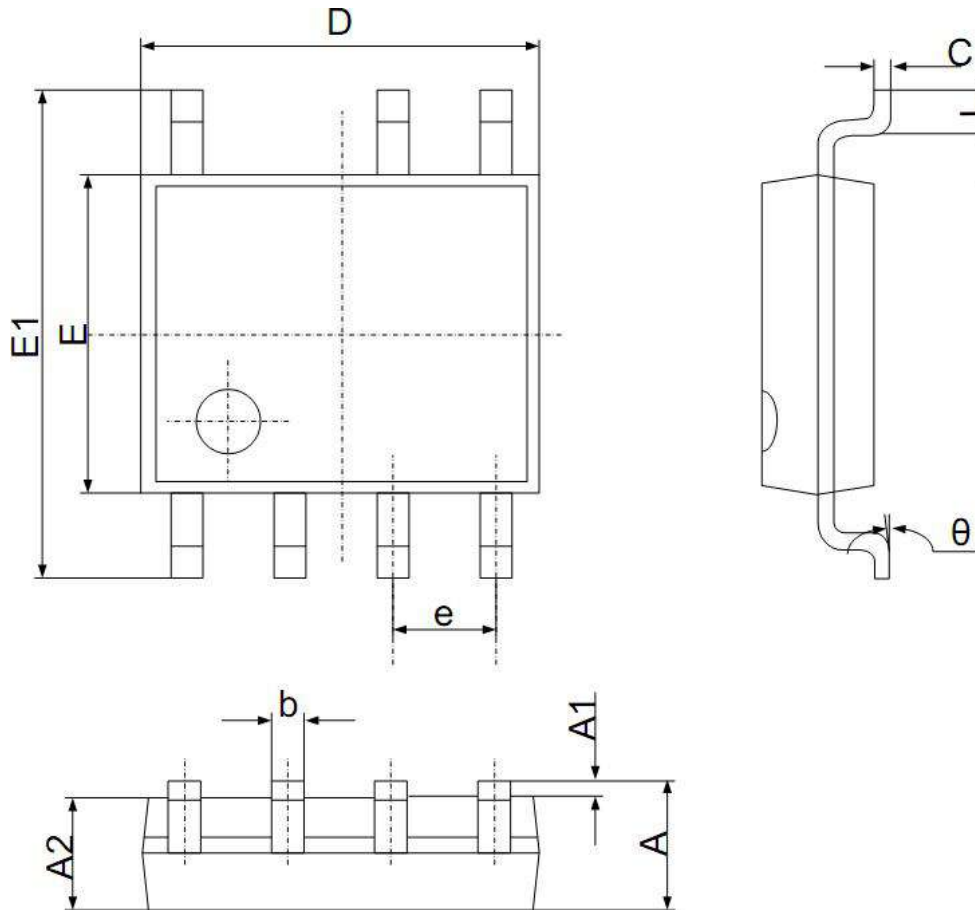
芯片触发保护后功率 MOSFET 将关断, 同时系统进入自动重启模式, 芯片内部的计时器开始工作。当计时器计时超过 500ms 时, 芯片将重置并重新开机。开机后若再次触发保护, 则系统将再次进入自动重启模式。

- 软驱动电路

ICW6215 内置有软驱动电路优化了系统 EMI 性能。

高性能、低成本离线式PWM控制功率开关

封装尺寸

SOP-7


符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小	最大	最小	最大
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.002	0.010
A2	1.350	1.550	0.049	0.065
b	0.330	0.510	0.012	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.203
e	1.270 (中心到中心)		0.050 (中心到中心)	
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
E	3.800	4.000	0.15	0.157
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°